

铁同位素窄电离带质谱分析

@邓中国\$原子能研究所!北京 @李华璋\$原子能研究所!北京 @刘炳寰\$原子能研究所!北京

收稿日期 1983-2-18 修回日期 网络版发布日期:

摘要 本工作采用 0.4 mm宽的窄电离带,减小了由于电离带表面高温热辐射引起的本底干扰。在电离带和样品带的加热电流分别为 4.0 A和1.8 A条件下,用 5 μ g氧化铁样品可以获得10~(-13)A稳定的离子束流近1小时。用这种方法测定了电磁分离器生产的各种浓缩铁同位素产品的丰度,测定精度为0.1%。

关键词 [铁同位素](#) [窄电离带](#) [丰度](#)

分类号

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [\[PDF全文\]\(194KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“铁同位素”的 相关文章](#)
- ▶ [本文作者相关文章](#)

Abstract

Key words

DOI

通讯作者